



特点

1. 中心放大门极结构
2. 平板型陶瓷管壳封装
3. 低通态和开关损耗

典型应用

1. 逆变器	$I_{T(AV)}$	4000A
2. 斩波器	V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
3. 感应加热	I_{TSM}	65KA
	I^2t	21125 10 ³ A ² S



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			Tj(°C)	最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=106^{\circ}\text{C}$	125			4000	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM}$, $t_p=10\text{ms}$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 100\text{V}$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_D = V_{DRM}$	125			200	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_R = V_{RRM}$	125			200	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽正弦半波	125			65	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6 V_{RRM}$	125			21125	A ² s*10 ³
V_{TO}	门槛电压		125			0.91	V
r_T	斜率电阻		125			0.09	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=1500\text{A}$, $F=15\text{KN}$	125			1.45	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\% V_{DRM}$	125			1000	V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\% V_{DRM}$ to 1000A 门极脉冲 $t_r \leq 0.5\mu\text{s}$ $I_{GM} = 1.5\text{A}$ 重复值	125			250	A/μs
I_{rm}	反向恢复电流	$I_{TM}=500\text{A}$, $t_p=1000\mu\text{s}$,	125			250	A
t_{rr}	反向恢复时间	$di/dt = -20\text{A}/\mu\text{s}$,	125			26	μs
Q_{rr}	恢复电荷	$V_R=50\text{V}$	125			3250	μC
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12\text{V}$, $I_A=1\text{A}$	25	35		450	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12\text{V}$, $I_A=1\text{A}$	25	0.8		3.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12\text{V}$, $I_A=1\text{A}$	25	20		1000	mA
T_{stg}	存储温度	$V_A=12\text{V}$, $I_A=1\text{A}$		-40		140	°C

性能曲线图

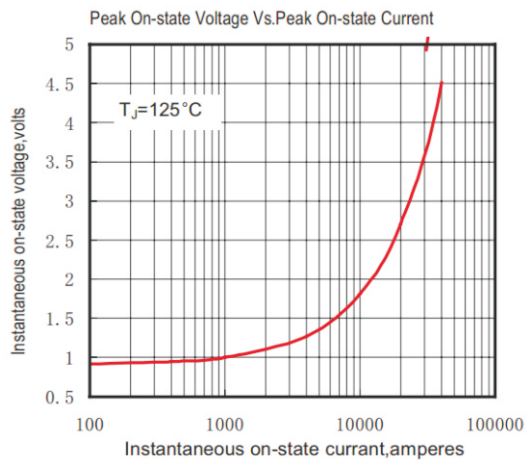


Fig.1

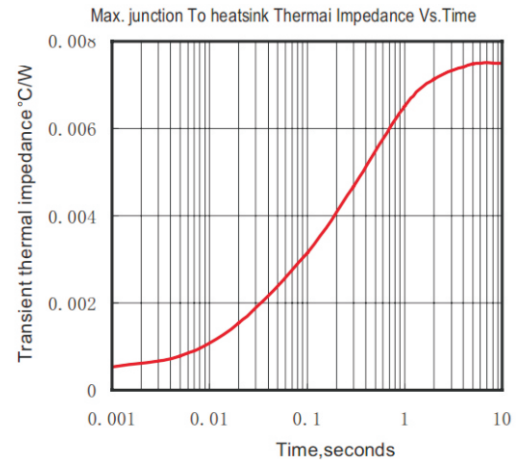
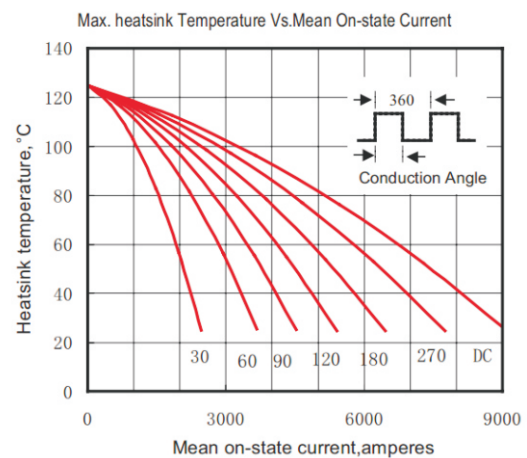
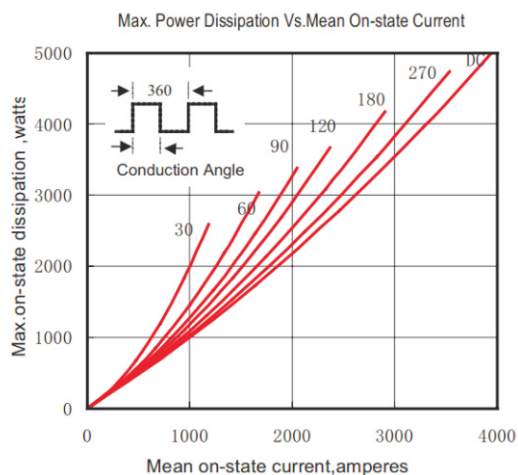
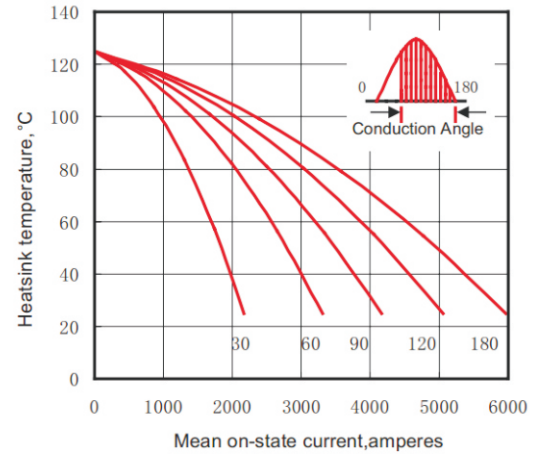
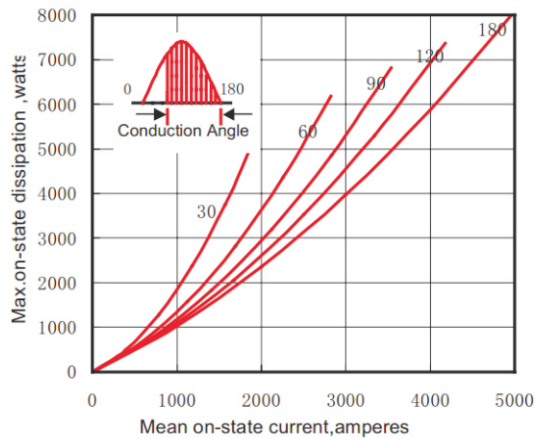
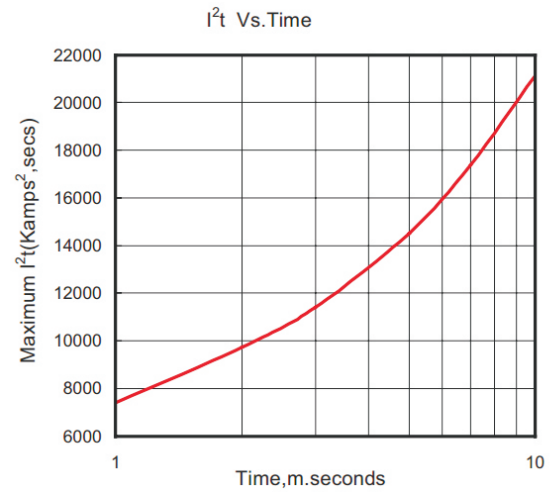
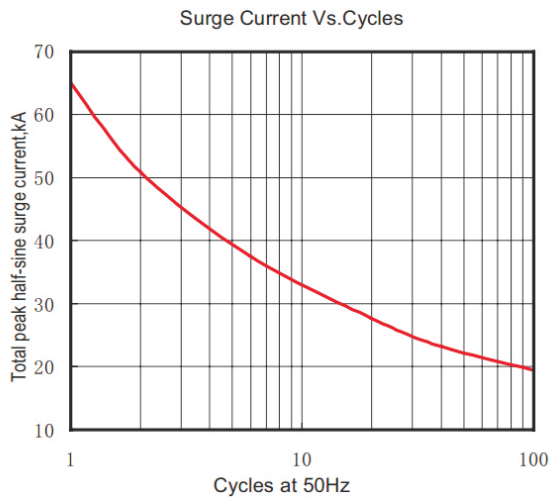


Fig.2





外形尺寸图

